

Mg含量对N掺杂MgZnO薄膜的光电性能和N掺杂行为的影响

高丽丽^{1,2}, 徐莹², 张淼¹, 姚斌²

1. 北华大学 物理学院, 吉林 吉林 132013;
2. 吉林大学 物理学院, 吉林 长春 130012

Effects of Mg contents on photoelectric properties and N doped behaviors in N doped MgZnO films

GAO LI-li^{1,2}, XU Ying², ZHANG Miao¹, YAO Bin²

1. College of Physics, Beihua University, Jilin 132013, China;
2. College of Physics, Jilin University, Changchun 130012, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(2\)](#)

访问总数: 405721

版权所有 © 2012 《光学精密工程》编辑部

地址: 长春市东南湖大路3888号 邮编: 130033 E-mail: gxjmgc@sina.com

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发